

**薄膜材料デバイス研究会 第18回研究集会「結晶成長技術とデバイスの新展開」
タイムテーブル（1日目）**

日付	時間	セッション	備考	座長(案)
11/11 (木)	9:55 - 10:00	チュートリアル： イントロダクトリー 酒井 正俊 (千葉大学)	Zoom ウェビナー	酒井 正俊 (千葉大学) 市川 和典 (松江工業高等専門学校)
	10:00 - 11:00	チュートリアル1： (招待講演) 「Si膜中のレーザー誘起単結晶成長技術 ---{001}<100>結晶方位制御を中心に---」 葉 文昌 (島根大学)		
	11:00 - 12:00	チュートリアル2： (招待講演) 「インテリジェント制御による半導体製造装置のイノベーション」 守屋 剛 (東京エレクトロン)		
	12:00 - 13:00	昼食 (60分)		
	13:00 - 13:10	開会式 実行委員長 東 清一郎 (広島大学)		
	13:10 - 14:50	オーラルセッション1： 結晶成長の新展開 13:10~13:50 (招待講演) 「生命に関わる結晶の多形 ~尿路結石の形成~」 丸山 美帆子 (大阪大学) 13:50~14:10 「培養時間によるPbSの粒径制御」小西 拓実 (広島大学) 14:10~14:30 「300cm ² /Vs 以上の粒内正孔移動度を示す非平衡岩塩型 (Sn, Ca)Se エピタキシャル薄膜」ホ シンイ (東工大) 14:30~14:50 「間欠パルス加熱支援プラズマCVDによる高結晶シリコン膜の成長制御」野島 大志 (広島大学)	Zoom ウェビナー	大平 圭介 (北陸先端大) 東 清一郎 (広島大)
	14:50 - 15:05	企業コマースシャル・休憩		
	15:05 - 16:45	オーラルセッション2： 新材料・新評価技術 15:05~15:45 (招待講演) 「有機半導体の伝導帯バンド構造の実測とポーラロン形成の実証」吉田 弘幸 (千葉大学) 15:45~16:05 「糸状試料に対する3 ω 法を用いた熱伝導率精密測定における誤差要因の検討」関本 祐紀 (奈良先端大) 16:05~16:25 「逆ペロブスカイト型酸化物 Ba ₃ (Si, Ge)O の高純度バルク合成と電気特性評価」木村 茂 (東工大) 16:25~16:45 「マイクロ熱プラズマジェットミリ秒アニールによるIV族半導体薄膜の結晶化と常磁性欠陥」佐藤 拓磨 (広島大学)		中村 雅一 (奈良先端大) 神谷 利夫 (東工大)
	16:45 - 17:00	企業コマースシャル・休憩		
	17:00 - 18:00	移動・休憩		
	18:00 - 20:35	ランブセッション 18:00~19:00 (特別招待講演) 「二流の研究者ではアウトでしょうか？」 島海 明 (東京大学) 19:00~19:20 (海外特別招待講演) 「海外への挑戦 -研究者としてどう生きるか-」前田 拓也 (米・コーネル大学) 19:20~19:35 休憩 19:35~19:55 「金属顕微鏡を用いたアルカンチオール単分子有機膜の可視化」 服部 吉晃 (神戸大学) 19:55~20:15 「高移動度水素化多結晶In ₂ O ₃ :H薄膜トランジスタ」 曲 勇作 (島根大学) 20:15~20:35 「IGZO薄膜を利用した3層ニューロモルフィックデバイス」 岩城 江津子 (龍谷大学)	Zoom ミーティ ング	市川 和典 (松江工業高等専門学校) 古田 守 (高知工科大)